

Указания по эксплуатации

1. Указания по применению и эксплуатации по ОСТ В Н 073.067-82, ОСТ Н 073.062-84 и БКО.347.151 ТУ.

2. До монтажа микросхем в ГС необходимо разводку контактных шин "питание" и "общий" на плате РЭД соединить электрически между собой.

При монтаже необходимо соблюдать следующую последовательность: вначале присоединяется вывод микросхемы "общий", затем "питание", потом остальные выводы.

3. Категорически запрещается эксплуатация микросхем в составе негерметичных модулей, корпусов и т.д.

4. При монтаже должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла с защитным покрытием выше $+85^{\circ}\text{C}$.

5. При монтаже микросхем в ГС не разрешается изгиб выводов ближе, чем на 0,3 мм по длине вывода от места выхода из защитного покрытия и перегиб на инструменте с острыми краями. Не допускается пережатие (расплющивание) выводов.

6. Последовательность подачи напряжений на микросхему следующая:

- напряжение питания;

- входное напряжение.

Последовательность снятия напряжения:

- входное напряжение;

- напряжение питания.

7. Свободные входы микросхем должны быть соединены с одной из шин питания.

8. Для крепления микросхем необходимо использовать составы, не растворяющие защитного покрытия микросхемы. При монтаже микросхем в герметизированную гибридную микросхему не допускается наличие внутри корпуса микросхемы паров этилового спирта, дибутылфталата, этилцеллозоляда, полиэтиленполиамин и других веществ, разрушающих покрытие микросхем.

9. Рекомендуется дополнительная просушка гибридной микросхемы перед герметизацией при температуре не более 25°C .

10. Выводы микросхем при монтаже рекомендуется подсоединять сваркой. Время теплового импульса не более 0,2 с с интервалом не менее 0,5 с.

Температура жала паяльника не должна превышать 265°C .

11. Допустимое значение электростатического потенциала не более 100 В.

12. При эксплуатации и изменении электропараметров с целью исключения влияния измерительных устройств на результаты измерения, допускается одновременно совмещать все уровни входных и питающих напряжений на одинаковую величину, сохраняя разность потенциалов между выводами микросхем.

13. Допускается случайное превышение импульса напряжения управляющего входа над напряжением питания на одном выводе не более 1 В при длительности импульса на уровне 0,5 В не более 1 мкс и скважности не менее 2.

14. Допускается случайный отрицательный импульс управляющего входа на одном (любом) выводе не более 1 В при длительности импульса на уровне 0,5 В не более 1 мкс и скважности не менее 2.

15. Неиспользуемые входы (выходы) микросхемы соединить с выводом 7.